半导体材料与物理

2.能带理论

中国科学技术大学微电子学院 吕頔

课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
 - 主要内容: 如何推断半导体中电子状态
- 第三部分: 热力学统计
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子

第二部分: 能带结构

- 晶体能带的严谨处理方法
- 实际半导体的能带结构
 - 硅的能带结构
 - 金刚石晶体的能带结构
 - 闪锌矿晶体的能带结构
 - 纤锌矿晶体的能带结构
- 实际半导体能带结构的规律

近自由电子近似

- 单电子近似: 电子的运动可看作是相互独立的
- 周期势近似: 电子在一个具有晶格周期性的等效势场中运动
- 薛定谔方程为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + \nabla\psi = -i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

• 周期性条件为:

$$V(x+R)=V(x)$$

晶体波函数的求解

薛定谔方程
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+V\psi=-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

$$V=\sum_{\pmb{R}}-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\pmb{x}-\pmb{R}|}$$
 其中 \pmb{R} 为任意正格矢

可证明,波函数也具有布洛赫波形式 $\psi_{k} = e^{i(k\cdot x - \omega t)}u_{k}(x)$

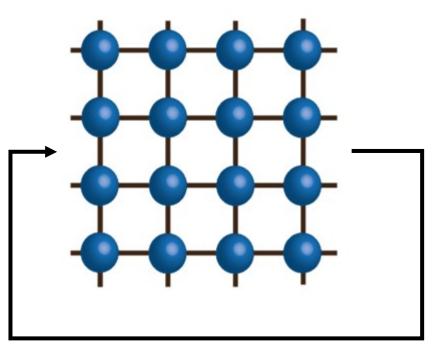
k脚标标注了波函数也是k的函数 k在布里渊区之内均匀分布,间隔为 $\frac{2\pi}{L}$ L为晶体长度

$$u_k(x)$$
满足 $u_k(x+R) = u_k(x)$ $u_k(x)$ 近似就是原子轨道

k的分布的证明

周期性边界条件

 $\psi_k(x+L) = \psi_k(x)$ L为x、y、z方向上的晶体尺寸



晶格一定得是立 方晶格吗?

$$\psi_{\pmb{k}}(\pmb{x}+\pmb{L}) = e^{i(\pmb{k}\cdot(\pmb{x}+\pmb{L})-\omega t)}u_{\pmb{k}}(\pmb{x}+\pmb{L}) = e^{i\pmb{k}\cdot\pmb{L}}e^{i(\pmb{k}\cdot\pmb{x}-\omega t)}u_{\pmb{k}}(\pmb{x}) = e^{i\pmb{k}\cdot\pmb{L}}\psi_{\pmb{k}}(\pmb{x})$$
 因此 $k_xL = 2m_x\pi$, $k_yL = 2m_y\pi$, $k_zL = 2m_z\pi$ m_x , m_y , m_z 为整数 故 \pmb{k} 在布里渊区之内均匀分布,间隔为 $\frac{2\pi}{L}$

晶体波函数的性质

- 概率密度的周期性(实空间平移不变性)
 - $\psi_k(x+R)^*\psi_k(x+R) = \psi_k(x)^*\psi_k(x)$
- 波函数的倒空间平移不变性
 - $\bullet \ \psi_{k+b_j} = \psi_k$
- 能量本征态, $E = \hbar \omega$
 - $\hat{E}\psi_{k} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} e^{i(k\cdot x \omega t)} u(x) = \hbar \omega \psi_{k}, \quad E = \hbar \omega$
- 准动量(晶格动量) ħk
- 能带(色散关系)
 - 可由紧束缚模型近似算得,也可利用数值计算算得
 - 也可实验测得

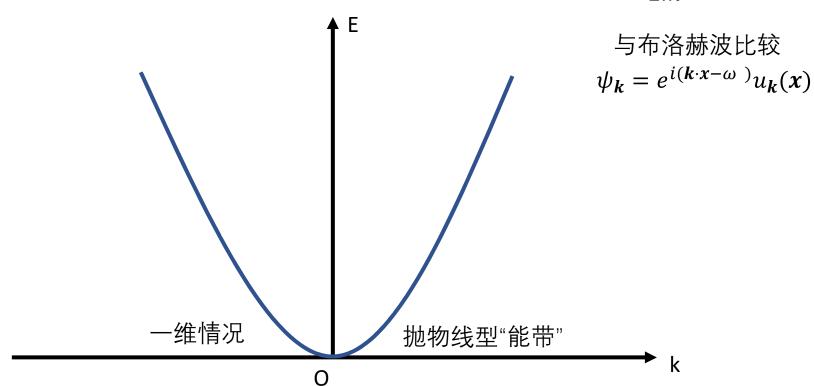
自由电子的波函数

电子状态由薛定谔方程解出

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + \nabla\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

自由电子受到最简单的"周期势场"V=0

$$\psi_{\mathbf{k}} = A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \qquad (\frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} = \hbar \omega)$$



周期性方势阱中电子的波函数

Kronig-Penney势

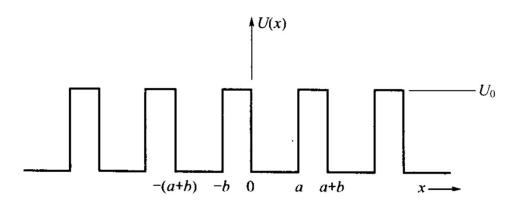


图 4 由克勒尼希和彭尼引入的方形周期势阱示意图。

周期势可以看做对自由电子势的"微扰", 能带应该和自由电子接近

向自由电子体系引入周期势之后, 能带偏离抛物线, 出现能隙

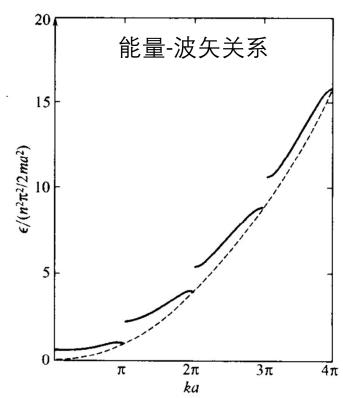
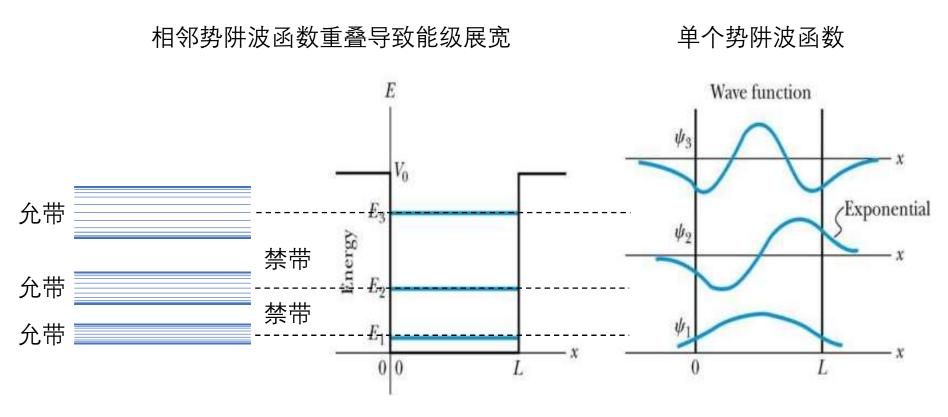


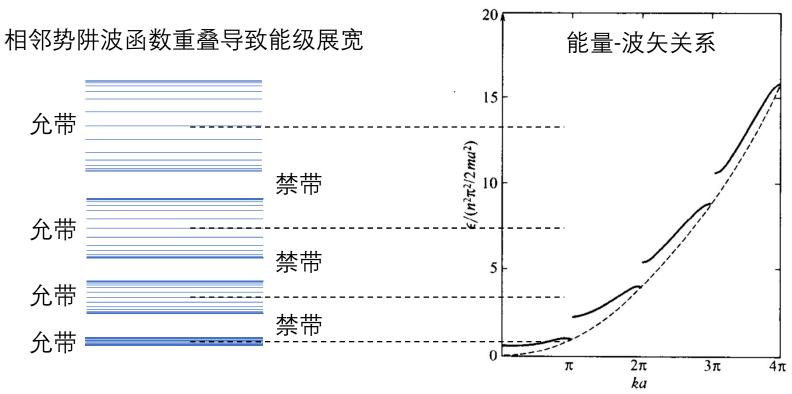
图 6 在克勒尼希—彭尼势场中的能量关于波数的关系曲线,其中 $P=3\pi/2$ 。请注意在 $ka=\pi$, 2π , 3π , … 处出现的能隙。

单个势阱能级展宽构成能带



单个势阱波函数线性组合→晶体波函数(布洛赫波) 单个势阱能级→晶体能带(上下展宽)

周期性方势阱中电子的波函数



为什么样子不像平常的能带结构?

图 6 在克勒尼希—彭尼势场中的 能量关于波数的关系曲线,其中 $P=3\pi/2$ 。请注意在 $ka=\pi$, 2π , 3π , ··· 处出现的能隙。

周期性方势阱中电子的能带

波函数的倒空间平移不变性 $\psi_{k+b} = \psi_k$

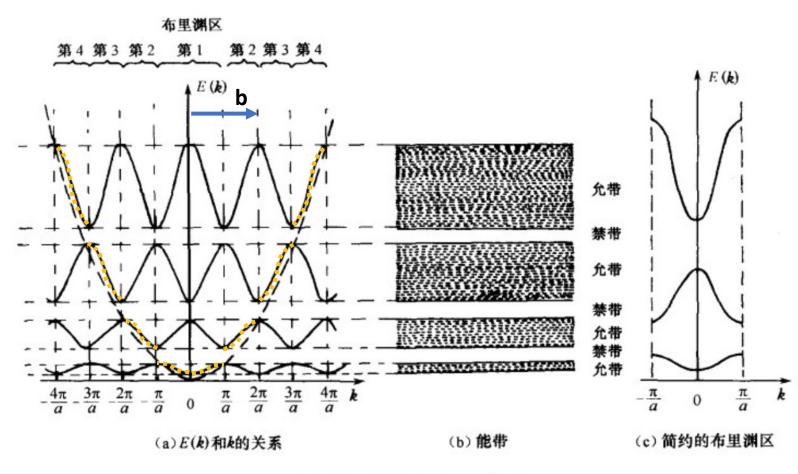
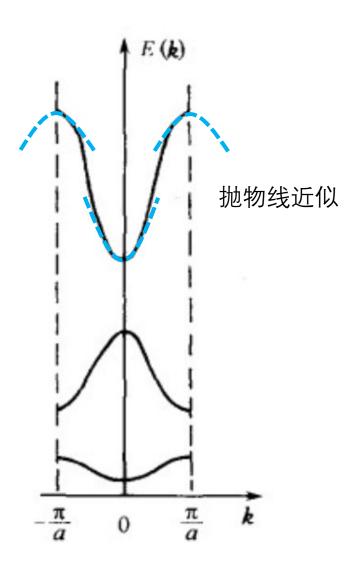


图 1-10 E(k)和 k 的关系

能带边缘电子的行为



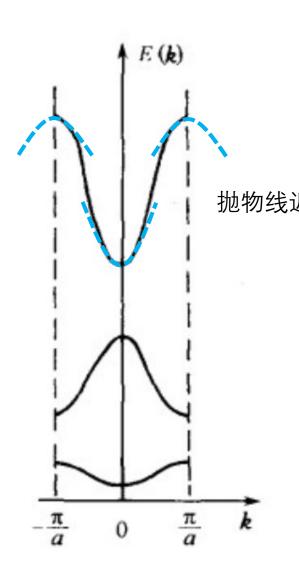
将E(k)在能带边缘(k_0 处)泰勒展开:

地物线近似
$$E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k_0}) + \frac{dE}{d\mathbf{k}} \Big|_{\mathbf{k_0}} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$

$$+ (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{d^2E}{2d\mathbf{k}^2} \Big|_{\mathbf{k_0}} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) + O(\mathbf{k}^3)$$
拉物线近似
$$\frac{dE}{d\mathbf{k}} \equiv (\frac{\partial E}{\partial k_x}, \frac{\partial E}{\partial k_y}, \frac{\partial E}{\partial k_z})$$

$$\frac{d^2E}{d\mathbf{k}^2} \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial^2E}{\partial k_x^2} & \frac{\partial^2E}{\partial k_x\partial k_y} & \frac{\partial^2E}{\partial k_z\partial k_x} \\ \frac{\partial^2E}{\partial k_x\partial k_y} & \frac{\partial^2E}{\partial k_y^2} & \frac{\partial^2E}{\partial k_y\partial k_z} \\ \frac{\partial^2E}{\partial k_z\partial k_x} & \frac{\partial^2E}{\partial k_y\partial k_z} & \frac{\partial^2E}{\partial k_y^2} \end{pmatrix}$$

能带边缘电子的行为



将E(k)在能带边缘(k_0 处)泰勒展开:

$$E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k_0}) + \frac{dE}{d\mathbf{k}} \Big|_{\mathbf{k_0}} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$
$$+ (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{d^2 E}{2d\mathbf{k^2}} \Big|_{\mathbf{k_0}} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) + O(\mathbf{k^3})$$

能带边缘为极值,则 $\left. \frac{dE}{d\mathbf{k}} \right|_{\mathbf{k_0}} = \mathbf{0}$

于是
$$E(\mathbf{k}) \sim E(\mathbf{k_0}) + (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{d^2 E}{2d\mathbf{k^2}} \Big|_{\mathbf{k_0}} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$

定义有效质量矩阵
$$m_n^* = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{d k^2} \Big|_{k_0} \right)^{-1}$$
 "-1"为逆矩阵 则 $E(k) \sim E(k_0) + (k - k_0) \cdot \frac{\hbar^2}{2} m_n^* - 1 \cdot (k - k_0)$ 行向量 矩阵 列向量

能带边缘电子的行为

$$E(\mathbf{k}) \sim E(\mathbf{k_0}) + (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{\hbar^2}{2} m_n^*^{-1} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$
 行向量 列向量

群速度
$$\boldsymbol{v} = \frac{d\omega}{d\boldsymbol{k}} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{d\boldsymbol{k}} \sim \hbar m_n^{*-1} \cdot (\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k_0})$$

运动方程 $Fdt = \hbar d\mathbf{k} = m_n^* \cdot d\mathbf{v}$

也即牛顿第二定律
$$\mathbf{F} = m_n^* \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$
 列向量 矩阵 列向量

当 m_n^* 为单位矩阵I的倍数时(对角、三个分量相同),可化为常数

$$\mathbf{F} = m_n^* \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

有效质量的意义 (一维)

• 有效质量大致是什么?

$$m^* = \hbar^2 / \frac{d^2 E}{dk^2}$$

- 半导体中载流子分布在导 带底、价带顶
- 此两处的能带接近抛物线
- 电子有效质量:
 - 导带底有效质量>0
 - 价带顶有效质量<0
- 电子速度 $v \sim \frac{\hbar k}{m^*}$

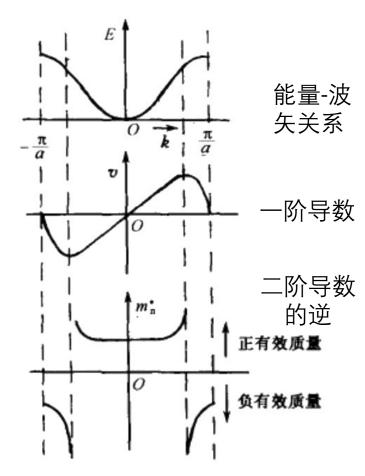


图 1-14 能量、速度和有效 质量与波矢的关系

等能面

对于确定的E,对应的k称为等能面

$$E(\mathbf{k}) \sim E(\mathbf{k_0}) + (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{\hbar^2}{2} m_n^{*-1} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$
 行向量 列向量

等能面的形状是?

当m*为单位矩阵I的倍数时

$$\frac{\hbar^2}{2}{m_n^*}^{-1}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k_0})^2 = E - E(\boldsymbol{k_0})$$

$$(k_x - k_{x0})^2 + \left(k_y - k_{y0}\right)^2 + (k_z - k_{z0})^2 = \frac{2(E - E(\boldsymbol{k_0}))m_n^*}{\hbar^2} \quad 为球心在\boldsymbol{k_0}的球面$$

能量距离带边越远、有效质量绝对值越大, 等能面越大

◆ 能带越平坦

等能面

对于确定的E.对应的k称为等能面

$$E(\mathbf{k}) \sim E(\mathbf{k_0}) + (\mathbf{k} - \mathbf{k_0}) \cdot \frac{\hbar^2}{2} m_n^*^{-1} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k_0})$$
 行向量 列向量

等能面的形状是?

当 m_n^* 为非单位矩阵的倍数时, 能带向各个方向的伸展情况有所不同(称为"各向异性")

可以证明,可适当选取x、y、z坐标轴,使得 m_n^* (或 m_n^{*-1})对角化

$$\frac{\hbar^{2}}{2}(k_{x}-k_{x0} \quad k_{y}-k_{y0} \quad k_{z}-k_{z0})\begin{pmatrix} m_{nx}^{*}^{-1} & 0 & 0\\ 0 & m_{ny}^{*}^{-1} & 0\\ 0 & 0 & m_{nz}^{*}^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} k_{x}-k_{x0}\\ k_{y}-k_{y0}\\ k_{z}-k_{z0} \end{pmatrix} = E - E(\mathbf{k_{0}})$$

即
$$\frac{(k_x - k_{x0})^2}{m_{nx}^*} + \frac{(k_y - k_{y0})^2}{m_{ny}^*} + \frac{(k_z - k_{z0})^2}{m_{nz}^*} = \frac{2(E - E(\mathbf{k_0}))}{\hbar^2}$$
 为球心在**k**₀的椭球面

半长轴、半中轴、半短轴分别为?

有效质量的意义 (三维)

• 有效质量大致是什么? 能带弯曲度(二阶导)

$$m^* = \hbar^2 / \frac{d^2 E}{dk^2}$$

- 各向异性时,各个方向的能带弯曲度不同
- 牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m_n^* \cdot \frac{dv}{dt}$ 在各个方向不同
- F和a甚至可以不在一个方向上

态密度:单位能量中电子态的数目

波矢之间的间距: $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$

k空间中单位体积含有的波函数(电子态)的数目: $\frac{dZ}{d\mathbf{k}^3} = \left(\frac{1}{\Delta k}\right)^3 = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3$ 考虑自旋再乘以2

E到E+dE之间可取的波矢有多少个?

当等能面为球形时

E到E+dE之间的体积是等能面包围的体积相减,即4π/3 [(k+dk)³-k³]=4πk²dk

因此
$$dZ = 2\left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 4\pi k^2 dk$$

$$k = |\mathbf{k}| = \frac{\sqrt{2m_n^*(E - E(\mathbf{k_0}))}}{\hbar} \qquad \frac{dE}{dk} = \frac{d}{dk} \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} = \frac{\hbar^2}{m_n^*} k = \frac{\hbar\sqrt{2m_n^*(E - E(\mathbf{k_0}))}}{m_n^*}$$

态密度 DOS =
$$\frac{dZ}{dE} = \frac{L^3 m_n^* \sqrt{2m_n^* \left(E - E(\mathbf{k_0})\right)}}{\pi^2 \hbar^3}$$

态密度:单位能量中电子态的数目

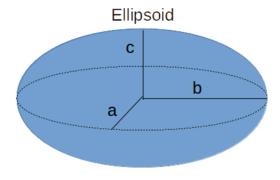
波矢之间的间距: $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$

k空间中单位体积含有的波函数(电子态)的数目: $\frac{dZ}{d\mathbf{k}^3} = \left(\frac{1}{\Delta k}\right)^3 = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3$ 考虑自旋再乘以2

E到E+dE之间可取的波矢有多少个?

当等能面为椭球形时,E到E+dE之间的体积是?

椭球的体积是?



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$V = \frac{4}{3}\pi abc$$

椭球面方程

椭球体积

令
$$k = |\mathbf{k}| = \frac{\sqrt{2m(E - E(\mathbf{k_0}))}}{\hbar}$$
 三个半轴有 $k_x = \sqrt{\frac{m_{nx}^*}{m}}k$ $k_y = \sqrt{\frac{m_{ny}^*}{m}}k$ $k_z = \sqrt{\frac{m_{nz}^*}{m}}k$

态密度:单位能量中电子态的数目

是一种专门用于计算态密度所使用的各向异性有效质量的平均值

空穴

- 在能带顶,有效质量为负
 - 为了避免这一现象,定义假想粒子空穴
 - 其有效质量(矩阵) $m_p^* = -m_n^* = -\frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{d k^2} |_{k_0} \right)^{-1}$
 - 电荷为+e
 - 晶格动量为-ħk 注意符号)
- 此时,能带中电子等效地不参与导电(理解为不参与导电的满带+导电空穴)
 - 同一能带不能既电子导电又空穴导电
- 其余结论(态密度等)类似,不过 m_n^* 全部换为 m_p^*

空穴

$$\mathbf{F} = -\frac{\hbar d\mathbf{k}}{dt}$$
 $\mathbf{F} = m_p^* \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

• 等能面

能面
$$\frac{(k_x - k_{x0})^2}{m_{px}^*} + \frac{(k_y - k_{y0})^2}{m_{py}^*} + \frac{(k_z - k_{z0})^2}{m_{pz}^*} = \frac{2(E(\mathbf{k_0}) - E)}{\hbar^2}$$
文文章

• 态密度

反密度
$$DOS = |\frac{dZ}{dE}| = \frac{L^3 m_{dp}^* \sqrt{2m_{dp}^* (E(\mathbf{k_0}) - E)}}{\pi^2 \hbar^3} \qquad m_{dp}^* = (m_{px}^* m_{py}^* m_{pz}^*)^{\frac{1}{3}}$$
 态密度有效质量